



MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES

NUMERO DE PUBLICATION : 1010420A3

NUMERO DE DEPOT : 09600637

Classif. Internat. : C23C

Date de délivrance le : 07 Juillet 1998

Le Ministre des Affaires Economiques,

Vu la loi du 28 Mars 1984 sur les brevets d'invention, notamment l'article 22;

Vu l'arrêté royal du 2 Décembre 1986 relatif à la demande, à la délivrance et au maintien en vigueur des brevets d'invention, notamment l'article 28;

Vu le procès verbal dressé le 12 Juillet 1996 à 14H40 à l'Office de la Propriété Industrielle

ARRETE:

ARTICLE 1.- Il est délivré à : RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT DU GROUPE COCKERILL SAMBRE, en abrégé RD-CS
boulevard de Colonster B 57, B-4000 LIEGE(BELGIQUE)

représenté(e)(s) par : VOSSWINKEL Philippe, GEVERS Patents S.A., Brussels Airport
Bus. Park-Holidaystr. 5-1831 DIEGEM.

un brevet d'invention d'une durée de 20 ans, sous réserve du paiement des taxes annuelles, pour : PROCEDE POUR LA FORMATION D'UN REVETEMENT SUR UN SUBSTRAT ET INSTALLATION POUR LA MISE EN OEUVRE DE CE PROCEDE.

ARTICLE 2.- Ce brevet est délivré sans examen préalable de la brevetabilité de l'invention, sans garantie du mérite de l'invention ou de l'exactitude de la description de celle-ci et aux risques et périls du(des) demandeurs(s).

Bruxelles, le 07 Juillet 1998
PAR DELEGATION SPECIALE :

L. WUYTS
CONSEILLER

**"Procédé pour la formation d'un revêtement sur un
substrat en installation pour la mise
en oeuvre de ce procédé"**

5 La présente invention est relative à un
procédé pour le dépôt, sur un substrat, d'un revêtement
constitué essentiellement d'un composé conducteur
électronique.

10 Suivant une des techniques connues jusqu'à
présent, l'on forme un tel revêtement par pulvérisation
cathodique réactive, encore appelée "sputtering réac-
tif". Un tel procédé présente surtout l'inconvénient
d'une vitesse de dépôt relativement lente par suite de
la contamination des cibles utilisées à partir desquel-
les la pulvérisation est réalisée.

15 Une autre technique connue est celle de
l'évaporation sous vide activée appelée "ARE" (Activated
Reactive Evaporation). Cette technique pose également
un problème de contamination du système d'évaporation,
ce qui réduit considérablement le rendement de dépôt.

20 Un des buts essentiels de la présente inven-
tion est de proposer un procédé du type précité permet-
tant de réaliser à grande vitesse un revêtement sur un
substrat, conducteur d'électricité ou non, et ceci
essentiellement d'épaisseur relativement importante.

25 Il s'agit, plus particulièrement, d'un procédé
de production de masse de couches de composés conduc-
teurs de l'électricité ayant une épaisseur de l'ordre de
1000 Å sur un substrat formé par exemple d'acier au
défilé, de verre plat, d'une feuille de papier ou d'un
30 film de plastique.

 A cet effet, suivant l'invention, l'on forme
ledit revêtement en produisant alternativement, d'une

part, dans au moins une zone de dépôt, un ou plusieurs dépôts d'une épaisseur déterminée d'un élément conducteur électronique, tel qu'un métal, un alliage, un semi-conducteur du type dopé N, sur le substrat et, d'autre
5 part, dans au moins une zone de réaction, une ou plusieurs réactions de l'élément ainsi déposé avec des ions d'un gaz réactif qui sont implantés dans le dépôt de l'élément susdit sur sensiblement toute cette épaisseur déterminée de manière à former avec sensiblement la
10 majorité et de préférence la quantité totale de cet élément, ledit composé, les ions susdits étant soumis à une énergie cinétique inférieure à 2000V, de préférence de 200 à 900V, tandis que l'épaisseur précitée du dépôt de l'élément est déterminée en fonction de l'énergie
15 cinétique appliquée d'une manière telle à ce que l'implantation de ces ions puisse avoir lieu sur sensiblement toute cette épaisseur.

Avantageusement, l'on effectue la réaction précitée de l'élément déposé sur le substrat avec le gaz
20 réactif précité en créant, en regard et à proximité de la surface de ce dernier présentant le dépôt de l'élément, un plasma dans lequel on introduit le gaz réactif précité, de manière à y former ainsi des ions pénétrant dans le dépôt de l'élément, sensiblement sur une profon-
25 deur correspondant à l'épaisseur de ce dépôt pour les faire réagir avec l'élément déposé.

Suivant une forme de réalisation particulière de l'invention, l'on applique, dans la zone de réaction, au substrat un potentiel négatif par rapport à une
30 anode.

Suivant une forme de réalisation avantageuse, le dépôt de l'élément par évaporation, de préférence sous vide, est suivi d'une condensation sur le substrat.

Suivant une forme de réalisation particulièrement
35 ment avantageuse, l'on forme le dépôt de l'élément sur le substrat par pulvérisation cathodique.

Suivant une forme de réalisation préférée de l'invention, on forme sur le substrat un revêtement constitué d'une couche d'un composé céramique conducteur électronique, par exemple un composé du type TiN, ZrN, 5 TiCN, CrN, VN, NbN, InSnO, obtenu par la réaction d'au moins un métal et d'un gaz réactif, en effectuant d'abord, dans la zone de dépôt, un dépôt dudit métal sur le substrat et, ensuite, dans la zone de réaction, une ionisation du gaz, dans un plasma, formé en regard de ce 10 dépôt, et une implantation de particules ionisées de ce gaz dans ce dépôt de métal, ce dernier étant mis à un potentiel négatif par rapport au gaz ionisé.

L'invention concerne également une installation particulière pour la mise en oeuvre du procédé 15 précité.

Cette installation est caractérisée en ce qu'elle comprend au moins une zone de dépôt, dans laquelle peut se former un dépôt d'un élément conducteur électronique sur le substrat, cette zone de dépôt étant 20 suivie d'au moins une zone de réaction séparée de cette zone de dépôt, où peut être créée une implantation, dans le dépôt susdit de particules pouvant réagir avec cet élément pour former le composé conducteur électronique, des moyens étant prévus pour déplacer, de préférence 25 d'une manière continue, le substrat de la zone de dépôt vers la zone de réaction.

D'autres détails et particularités de l'invention ressortiront de la description donnée ci-après, à titre d'exemples non limitatifs, de quelques formes de 30 réalisation particulières de l'invention avec référence aux dessins annexés.

La figure 1 est une vue schématique en élévation d'une première forme de réalisation, suivant l'invention, d'une installation pour la formation d'un 35 revêtement sur un substrat.

La figure 2 est une vue schématique, analogue à celle de la figure 1, d'une deuxième forme de réalisation, suivant l'invention, d'une installation pour la formation d'un revêtement sur un substrat.

5 La figure 3 est également une vue schématique analogue à celle des figures 1 et 2, d'une troisième forme de réalisation, suivant l'invention, d'une installation pour la formation d'un revêtement sur un substrat.

10 La figure 4 est encore une vue schématique d'une quatrième forme de réalisation, suivant l'invention, d'une installation pour la formation d'un revêtement sur un substrat.

15 Dans les différentes figures, les mêmes chiffres de référence concernent des éléments analogues ou identiques.

20 D'une façon générale, l'invention consiste à proposer un procédé pour le dépôt, sur un substrat, d'un revêtement constitué essentiellement d'un composé conducteur électronique.

Le substrat peut par exemple être formé de tôles d'acier au défilé, de plaques de verre plat, de feuilles de papier ou de films en matière plastique.

25 Le revêtement peut être obtenu par la production de masse de couches, par exemple, de composés métalliques ou céramiques dont l'épaisseur est généralement de l'ordre de 500 à 2000 Å. A cet égard, le procédé suivant l'invention, se caractérise par le fait que l'on forme d'abord une couche séparée sur le substrat dans une zone de dépôt d'un élément conducteur électronique, tel qu'un métal, un alliage ou un semi-conducteur du type dopé N, d'une épaisseur déterminée relativement réduite. Ensuite, dans une zone de réaction, qui est séparée de la zone de dépôt, on crée un gaz réactif contenant des ions qui non seulement peuvent
35 réagir avec l'élément précité, mais qui, de plus,

possèdent suffisamment d'énergie cinétique pour pouvoir s'implanter sur toute l'épaisseur déterminée précitée du dépôt ou de la couche de l'élément sur le substrat.

5 Cette énergie cinétique est avantageusement maintenue en dessous de 2000 V, de préférence entre 200 et 900 V, tandis que l'épaisseur déterminée précitée est telle que l'implantation des ions du gaz réactif puisse avoir lieu sur sensiblement toute cette épaisseur et que ces ions puissent réagir avec la totalité de l'élément
10 formant cette couche de dépôt. Ces étapes de dépôt et de réaction subséquente sont répétées autant de fois jusqu'à obtention de l'épaisseur finale désirée du revêtement

Suivant une forme de réalisation avantageuse
15 de l'invention, on crée, dans la zone de réaction, en regard et à proximité du substrat, un plasma, dans lequel on introduit le gaz réactif précité de manière à y former des ions pouvant réagir, par implantation, avec l'élément déposé préalablement sur le substrat.

20 Pour obtenir l'énergie cinétique nécessaire pour l'implantation des ions du gaz réactif dans la couche de dépôt de l'élément, l'on applique de préférence un potentiel négatif au substrat dans la zone de réaction pour polariser négativement le dépôt déjà formé
25 sur ce substrat et l'on crée, de plus, un circuit de confinement magnétique pour les électrons formés à proximité de la surface du substrat sur laquelle le revêtement est formé.

Le dépôt de l'élément conducteur précité peut
30 être formé par évaporation, de préférence sous vide, suivie d'une condensation sur le substrat, par pulvérisation cathodique, par une combinaison d'une évaporation et d'une pulvérisation cathodique ou encore au moyen d'un canon à ions.

35 La technique de la combinaison d'une évaporation et d'une pulvérisation cathodique fait l'objet de

la demande de brevet belge n° 09501052 du même déposant, tandis que les autres techniques constituent généralement des techniques connues en soi. A cet égard, il y a lieu de noter que le canon à ions est généralement moins
5 intéressant que les autres techniques citées.

La figure 1 montre schématiquement une forme de réalisation dans laquelle le dépôt de l'élément est formé par évaporation sous vide. Il s'agit d'une forme de réalisation particulière pour le recouvrement d'une
10 des faces d'un substrat 1 en forme d'une feuille continue, qui se déplace d'une manière sensiblement continue dans le sens de la flèche 2, d'abord à travers d'une première zone 3 où a lieu l'évaporation sous vide d'un métal 4 maintenu en fusion dans un creuset 5. Dans
15 cette zone, un film ou une couche 6 de ce métal est condensé sur la face de la tôle en regard du creuset 5. Le substrat 1 avec ce film 6 se déplace ensuite vers une deuxième zone 7, séparée de la première, dans laquelle on produit, dans un gaz réactif par exemple N_2 , CH_4 , un
20 plasma 8 qui permet de former dans ce gaz des ions. Ces ions s'implantent dans le film 6 pour réagir avec le métal, dont il est constitué, et former ainsi un revêtement 9 d'un composé conducteur électronique obtenu par la réaction du métal formant le film avec les ions pro-
25 duits.

Afin de donner aux ions l'énergie cinétique nécessaire pour pénétrer dans toute l'épaisseur du film 6, on applique au substrat 1, dans la zone 7, un potentiel négatif par rapport à une anode 10 agencée en
30 regard de ce substrat.

Signalons encore que le gaz réactif est introduit dans le plasma 8 par des injecteurs 11 montrés schématiquement à la figure 1 et appelés généralement "douches".

35 La densité des ions pénétrant dans le film 6 est encore accrue par la présence d'un circuit de

confinement magnétique du côté du substrat couvert par ce film. Ce circuit magnétique est créé par des aimants permanents ou éventuellement des électro-aimants 12 montés sur une plaque d'acier doux, représentés schématiquement à la figure 1, disposés à proximité du substrat 1, du côté opposé à celui où est formé le film 6.

La figure 2 est une représentation schématique d'une deuxième forme de réalisation de l'invention qui se rapporte à la formation d'un revêtement sur une des faces de plaques rigides notamment de verre 1 se déplaçant d'une manière sensiblement continue, dans le sens de la flèche 2, sur des rouleaux entraînés 13, mises à la masse, successivement à travers la zone de dépôt 3 et la zone de réaction 7.

Dans cette forme de réalisation, le dépôt du film 6 dans la zone de dépôt 3 est formé par pulvérisation cathodique.

Suivant cette technique, qui est connue en soi, on prévoit dans cette zone 3, en regard des plaques de verre 1, une cible de pulvérisation cathodique magnétron 14 pourvue, du côté dirigé vers ces plaques de verre, d'une couche du métal dont le film 6 est constitué. Cette couche de la cible 14 est bombardée par des ions de gaz inerte, tels que des ions d'argon, formés dans un plasma 15, qui éjectent des atomes de métal de cette cible 14 et forment sur le substrat le film précité 6. Ce gaz inerte est introduit dans la zone de dépôt 3 par des injecteurs 18 inclinés vers le bas.

La cible 14 est mise à un potentiel négatif, tandis que les rouleaux 13 sont également mis à la masse.

La zone de réaction 7, où a lieu l'implantation de ce film d'ions provenant du gaz réactif, est sensiblement identique à celle de la figure 1 et est séparée de la zone de dépôt par une paroi 20 dans laquelle est agencée une ouverture 21 pour le passage

des plaques de verre 1 de la zone de dépôt 3 vers la zone de réaction 7.

La figure 3 est une représentation schématique d'une troisième forme de réalisation qui diffère de celle représentée à la figure 2 par la nature du substrat 1, de la technique appliquée pour la formation du film de métal 6 dans la zone de dépôt et des moyens de transport du substrat 1 à travers les zones de dépôt 3 et 7. Dans cette troisième forme de réalisation, le substrat est formé d'une feuille flexible 1, d'un métal, ou d'une feuille souple de papier ou d'une matière plastique, telle que du polyéthylène ou polypropylène, qui est entraînée par des tambours 16 tournant en synchronisme autour de leur axe 17 dans le sens des flèches 2.

Dans la zone de dépôt 3 le film 6 est formé sur le substrat 1 par l'application de la technique combinée d'évaporation sous vide et de pulvérisation cathodique, telle que décrite dans la demande de brevet belge 09501052 du 20 décembre 1996 du même déposant.

Par conséquent, dans ce cas le métal 4 est maintenu à l'état liquide dans un creuset 5 maintenu à un potentiel négatif, en dessous duquel sont agencés des aimants 12 formant un circuit magnétique exactement comme dans la zone de réaction 7 des formes de réalisation précédentes.

La zone de réaction 7, qui suit la zone de dépôt 3 est séparée de cette dernière par une paroi 20, comme dans la deuxième forme de réalisation. Cette zone de réaction 7 se différencie des formes de réalisation précédentes par le fait que la feuille 1 formant le substrat est entraînée sur un tambour 16 et que les aimants 12, formant le circuit magnétique, sont agencés à l'intérieur du tambour, en regard de l'endroit où la feuille 1 est en contact avec ce dernier.

Un des avantages de l'installation suivant la figure 3 est qu'elle permet un refroidissement aisé du substrat aussi bien dans la zone de dépôt que dans la zone de réaction au moyen d'un liquide refroidisseur circulant à l'intérieur des tambours. Ceci peut être utile dans certains cas, par exemple pour le traitement de substrats à point de ramollissement relativement bas ou sujet à des transformations de phases.

La figure 4 est une représentation schématique d'une quatrième forme de réalisation de l'invention dans laquelle la formation du film 6 sur le substrat 1 dans les zones de dépôt 3 peut être réalisée par exemple comme dans les formes de réalisation précédentes.

Ce qui est, toutefois, typique dans cette quatrième forme de réalisation est qu'une zone de dépôt déterminée est séparée de la zone de dépôt subséquente par au moins deux zones de réaction consécutives distinctes. Ainsi, dans la figure 4 on a représenté entre deux zones de dépôt 3, trois zones de réaction consécutives 7a, 7b, 7c où le substrat 1 est soumis à un potentiel qui diffère d'une zone de réaction à la zone de réaction subséquente, de préférence à un potentiel décroissant, dans le sens de déplacement 2 du substrat 1, d'une zone de réaction à la zone de réaction suivante. Concrètement, la différence de potentiel dans la zone 7a peut par exemple être de l'ordre de 3000 V, celui dans la zone 7b de 1000 V et celui dans la zone 7c de 500 V.

L'invention est illustrée davantage par quelques exemples de réalisation concrets décrits ci-après.

Exemple 1

Cet exemple concerne la formation d'un revêtement de décoration de nitrure de zirconium sur une tôle d'acier en faisant usage d'une installation telle qu'illustrée par la figure 1 dans laquelle toutefois un

- 10 -

film de zirconium 6 est déposé sur la tôle 1, à partir d'une cible de zirconium 14, par pulvérisation cathodique, comme dans l'installation montrée à la figure 2.

La tôle d'une épaisseur de 0,2 mm se déplaçait à travers les zones 3 et 7 à une vitesse de l'ordre de 400 m/minute. La largeur de la cible de zirconium 14 dans les zones de réaction 3, suivant le sens de déplacement 2 de la tôle 1, était de 30 cm. Ainsi, le temps de passage de la tôle 1 devant la cible 14 était de 0,045 sec.

Dans cette zone de dépôt 3, on a injecté de l'argon à une pression de $5,10^{-3}$ Torr, tandis que la densité de puissance dissipée à la cible était de 75 W/cm².

Dans la zone de réaction 7, encore appelée zone d'implantation, on a injecté de l'azote également à une pression de 5.10^{-3} Torr, alors que la densité de puissance dissipée au substrat lors de l'implantation du film de zirconium était de 20 W/cm². La tension entre la tôle et l'anode était de 450 V.

En faisant passer successivement la tôle à travers dix sections de ce type, c'est-à-dire une zone de dépôt suivie d'une zone de réaction, on obtenait une tôle recouverte d'une couche finale homogène de nitrure de zirconium d'une épaisseur totale de 700 Å pouvant convenir parfaitement pour la décoration.

Exemple 2

Cet exemple concerne la formation d'une couche d'oxyde d'indium et de titane (InSnO), encore appelée "ITO", sur des plaques de verre, en faisant usage de l'installation telle qu'illustrée schématiquement par la figure 2 mais, mais dans laquelle, toutefois, la zone de dépôt 3 correspondait à celle de la forme de réalisation montrée à la figure 1. Ainsi, on avait prévu deux creusets successifs formant des cibles, un creuset contenant de l'étain liquide, l'autre contenant de l'indium

liquide. La surface du métal liquide dans chacun de ces creusets, exposée aux plaques de verre défilant en regard de ces derniers, présentait une largeur de 30 cm dans le sens de défilement. Comme dans le premier
5 exemple, la vitesse de déplacement des plaques était de 400 m/minute.

Dans la zone de dépôt, on a injecté de l'argon à une pression de $5 \cdot 10^{-3}$ Torr, tandis que la densité de puissance dissipée aux cibles était de 50 W/cm².

10 La largeur de la zone de réaction, notamment du circuit magnétique défini par les aimants formant un magnétron, était de 30 cm.

Dans cette zone, on a injecté de l'oxygène à une pression de $5 \cdot 10^{-3}$ Torr.

15 La tension dans cette zone entre le film composé d'indium et d'étain, préalablement formé dans la zone de dépôt sur les plaques de verre entrant dans la zone de réaction, était de 600 V et la densité de puissance dissipée sur le substrat était de 30 W/cm².

20 Comme dans l'Exemple 1, on a fait passer ces plaques de verre à travers dix zones de dépôt identiques entre chacune desquelles était intercalée une même zone de réaction. Ceci a permis d'obtenir des plaques de verre recouvertes d'une couche finale homogène et
25 transparente d'oxyde d'indium et d'étain d'une épaisseur de 1000 Å.

Exemple 3

Cet exemple concerne la formation d'un revêtement de nitrure de titane sur une feuille flexible
30 d'aluminium d'une épaisseur de 0,3 mm en faisant usage d'une installation du type de celle représentée à la figure 3.

Les conditions de travail et paramètres dans les zones de dépôt et de réaction correspondaient
35 sensiblement à celles de l'Exemple 1. Ceci a permis d'obtenir un revêtement homogène de nitrure de titane

- 12 -

d'une épaisseur de 500 Å après dix passages successifs
à travers une zone de dépôt et une zone de réaction.

REVENDEICATIONS

1. Procédé pour le dépôt, sur un substrat, d'un revêtement constitué essentiellement d'un composé conducteur électronique, caractérisé en ce que l'on
5 forme ledit revêtement en produisant alternativement, d'une part, dans au moins une zone de dépôt, un ou plusieurs dépôts d'une épaisseur déterminée d'un élément conducteur électronique, tel qu'un métal, un alliage, un
10 semi-conducteur du type dopé N, sur le substrat et, d'autre part, dans au moins une zone de réaction, une ou plusieurs réactions de l'élément ainsi déposé avec des ions d'un gaz réactif qui sont implantés dans le dépôt de l'élément susdit sur sensiblement toute cette épais-
15 seur déterminée de manière à former avec sensiblement la majorité et de préférence la totalité de cet élément ledit composé, les ions susdits étant soumis à une énergie cinétique inférieure à 2000V, de préférence de 200 à 900V, tandis que l'épaisseur précitée du dépôt de l'élément est déterminée en fonction de l'énergie
20 cinétique appliquée d'une manière telle à ce que l'implantation de ces ions puisse avoir lieu sur sensiblement toute cette épaisseur.

2. Procédé suivant la revendication 1, caractérisé en ce que l'on effectue la réaction précitée
25 de l'élément déposé sur le substrat avec le gaz réactif précité en créant, en regard et à proximité de la surface de ce dernier présentant le dépôt de l'élément, un plasma dans lequel on introduit le gaz réactif précité, de manière à y former ainsi des ions pénétrant
30 dans le dépôt de l'élément, sensiblement sur une profondeur correspondant à l'épaisseur de ce dépôt, pour les faire réagir avec l'élément.

3. Procédé suivant la revendication 2, caractérisé en ce que l'on applique au substrat un
35 potentiel négatif.

4. Procédé suivant l'une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que l'on forme le dépôt de l'élément sur le substrat par évaporation, de préférence sous vide, suivie d'une condensation.

5 5. Procédé suivant l'une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que l'on forme le dépôt de l'élément sur le substrat par pulvérisation cathodique.

10 6. Procédé suivant l'une quelconque des revendications 2 à 5, caractérisé en ce que l'on forme sur le substrat un revêtement constitué d'une couche d'un composé céramique conducteur électronique, par exemple un composé du type TiN, ZrN, TiCN, CrN, VN, NbN, obtenu par la réaction d'un métal et d'un gaz réactif,
15 en effectuant d'abord, dans la zone de dépôt, un dépôt dudit métal sur le substrat et, ensuite, dans la zone de réaction, une ionisation du gaz dans un plasma, formé en regard de ce dépôt, et une implantation de particules ionisées de ce gaz dans ce dépôt de métal, ce dernier
20 étant mis à un potentiel négatif par rapport au gaz ionisé.

7. Procédé suivant l'une quelconque des revendications 1 à 6, caractérisé en ce que l'on crée un circuit magnétique de confinement des électrons du côté
25 du substrat où a lieu la réaction de l'élément déposé avec le gaz réactif précité.

8. Procédé suivant l'une quelconque des revendications 1 à 7, caractérisé en ce que l'on prévoit, après chaque zone de dépôt de l'élément précité,
30 au moins deux zones de réaction successives séparées, le substrat étant soumis à un potentiel différent d'une zone de réaction à la zone de réaction subséquente.

9. Procédé suivant l'une quelconque des revendications 1 à 8, caractérisé en ce que le substrat
35 est formé d'une bande continue se déplaçant, de préfé-

rence d'une manière sensiblement continue, à travers les zones successives précitées.

10. Procédé suivant l'une quelconque des revendications 1 à 8, caractérisé en ce que, le substrat
5 étant formé d'une plaque, de telles plaques successives sont déplacées l'une à la suite de l'autre à travers les zones successives, le dépôt formé sur ces plaques dans la zone de dépôt étant mis à un potentiel négatif au moins dans la zone de réaction.

10 11. Procédé suivant l'une quelconque des revendications 1 à 10, caractérisé en ce qu'une excitation radio-fréquence, de préférence dans la gamme des microondes, est appliquée dans la zone de réaction précitée, à proximité de la surface du substrat sur
15 laquelle l'on forme le revêtement.

12. Installation pour le dépôt, sur un substrat, d'un revêtement constitué essentiellement d'un composé conducteur électronique, notamment installation pour la mise en oeuvre du procédé suivant l'une quelconque des revendications 1 à 11, caractérisée en ce
20 qu'elle comprend au moins une zone de dépôt, dans laquelle peut se former un dépôt d'un élément conducteur électronique sur le substrat, cette zone de dépôt étant suivie d'au moins une zone de réaction séparée de cette zone de dépôt, où peut être créée une implantation, dans
25 le dépôt susdit, de particules pouvant réagir avec cet élément pour former le composé conducteur électronique, des moyens étant prévus pour déplacer le substrat de la zone de dépôt vers la zone de réaction.

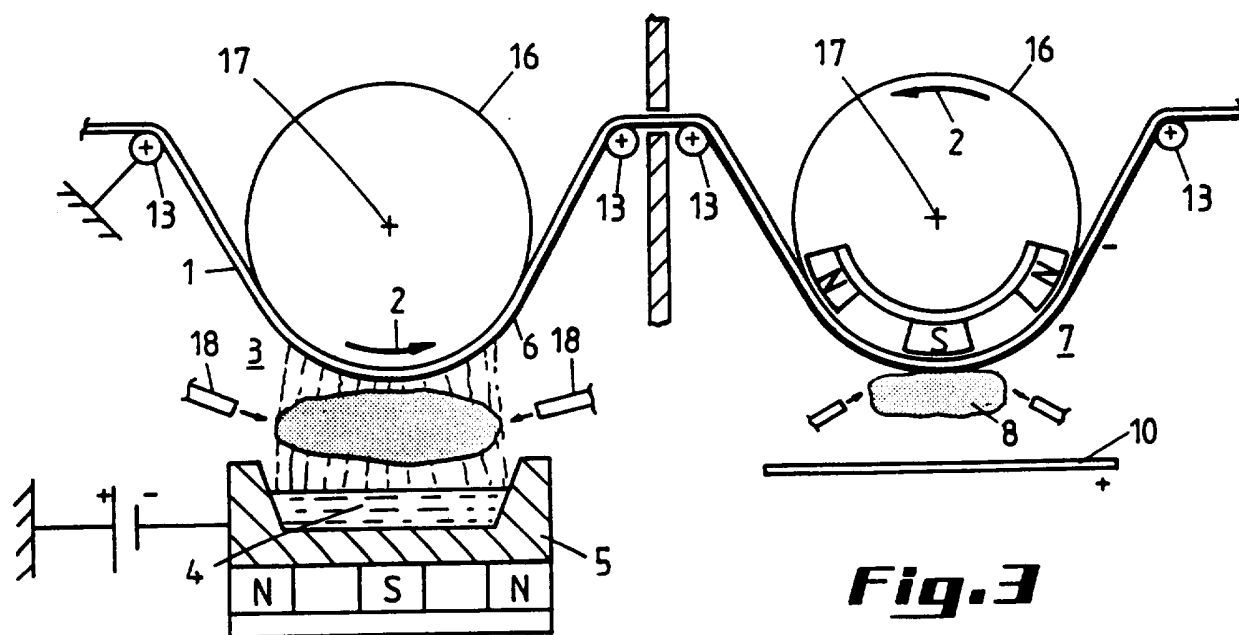
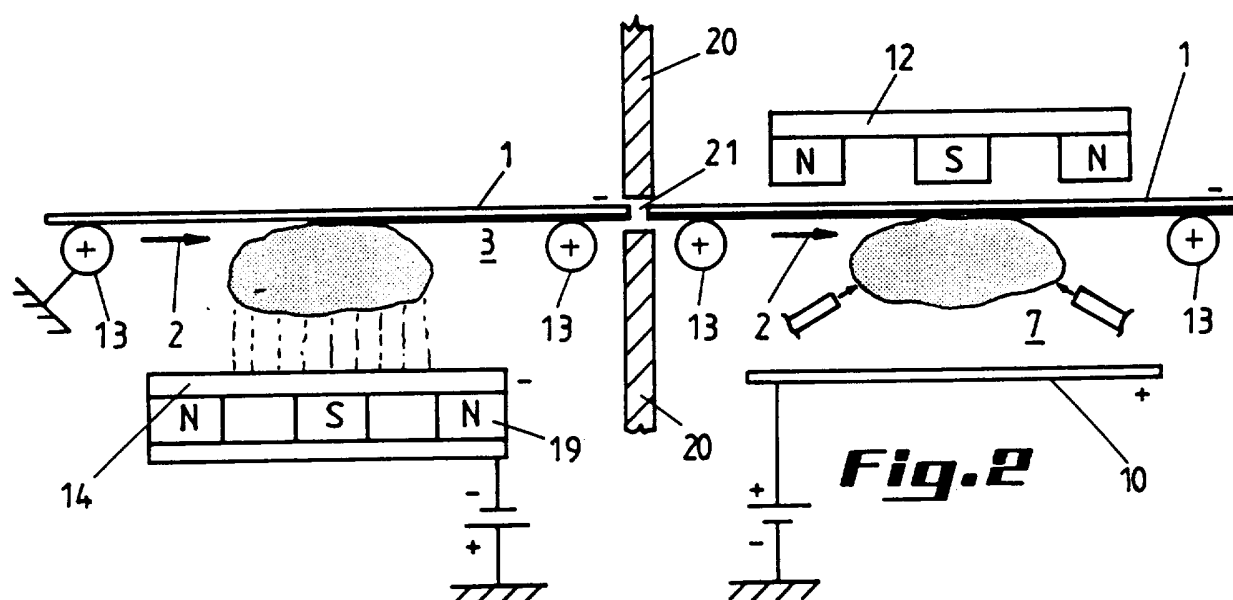
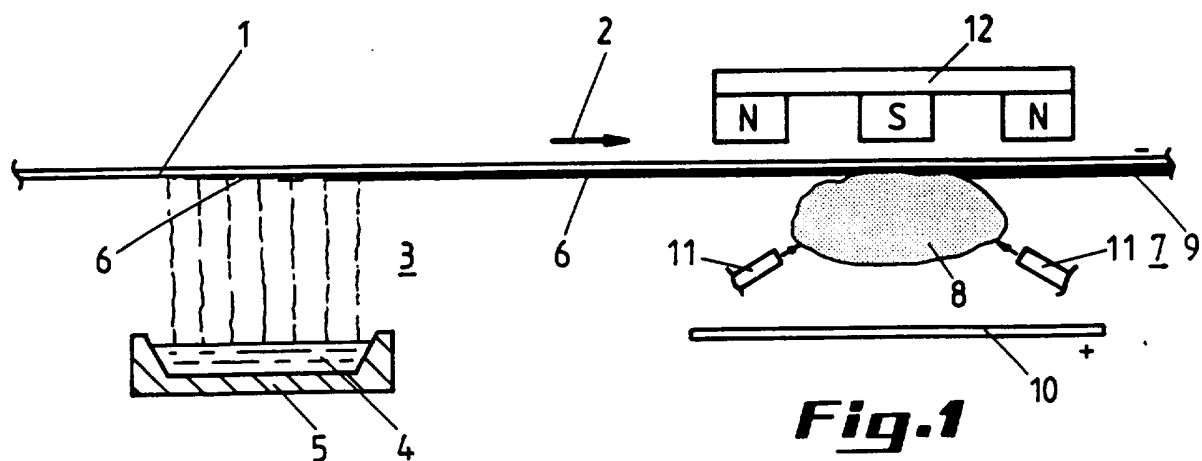
30 13. Installation suivant la revendication 12, caractérisée en ce que des moyens sont prévus pour appliquer, au moins dans la zone de réaction, au substrat un potentiel négatif par rapport à une anode agencée dans cette zone en regard du substrat.

35 14. Installation suivant l'une ou l'autre des revendications 12 et 13, caractérisée en ce que la zone

de dépôt précitée comprend un dispositif permettant de créer une évaporation, de préférence sous vide, suivie d'une condensation de l'élément sur le substrat.

5 15. Installation suivant l'une ou l'autre des revendications 12 et 13, caractérisée en ce que la zone de dépôt comprend une cible présentant une couche superficielle orientée vers le substrat et contenant l'élément à déposer sur ce dernier, des moyens étant prévus pour former un dépôt de cet élément à partir de
10 cette cible par pulvérisation cathodique.

16. Installation suivant l'une quelconque des revendications 12 à 15, caractérisée en ce qu'elle comprend, dans la zone de réaction, des moyens permettant d'ioniser des particules de gaz pouvant s'implanter
15 dans le dépôt de l'élément conducteur électronique précité.



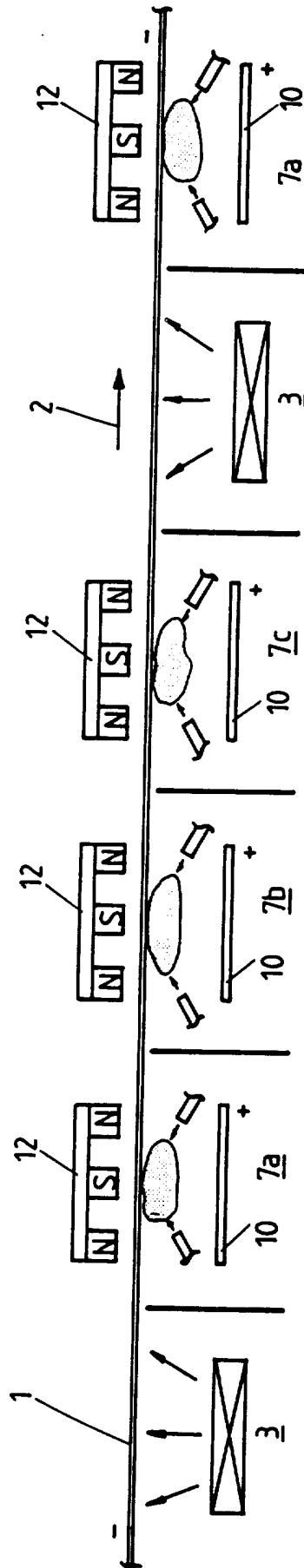


Fig. 4



Office européen
des brevets

RAPPORT DE RECHERCHE

établi en vertu de l'article 21 § 1 et 2
de la loi belge sur les brevets d'invention
du 28 mars 1984

Numero de la demande
nationale

BO 6161
BE 9600637

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS			
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	Revendication concernée	CLASSEMENT DE LA DEMANDE (Int.Cl.6)
X	US 3 594 238 A (HOECKELMAN RALPH E) 20 Juillet 1971	12-14, 16	C23C14/58
Y	* colonne 3, ligne 18 - colonne 4, ligne 27 *	1-6, 9	
Y	--- EP 0 655 515 A (OPTICAL COATING LABORATORY INC) 31 Mai 1995 * page 7, ligne 26 - page 8, ligne 48 * * page 11, ligne 45 - page 13, ligne 14 *	1-6, 9	
Y	--- GB 2 197 346 A (ATOMIC ENERGY AUTHORITY UK) 18 Mai 1988 * le document en entier *	1-6, 9	
A	--- PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 006, no. 049 (C-096), 31 Mars 1982 & JP 56 163262 A (ULVAC CORP), 15 Décembre 1981, * abrégé *	1-16	
A	--- US 4 740 385 A (FEUERSTEIN ALBERT ET AL) 26 Avril 1988 * colonne 2, ligne 67 - colonne 3, ligne 25 *	7	DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int.Cl.6)
	-----		C23C
Date d'achèvement de la recherche		Examineur	
25 Mars 1997		EKHULT, H	
CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES			
X : particulièrement pertinent à lui seul		T : théorie ou principe à la base de l'invention	
Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie		E : document de brevet antérieur, mais publié à la date de dépôt ou après cette date	
A : arrière-plan technologique		D : cité dans la demande	
O : divulgation non-écrite		L : cité pour d'autres raisons	
P : document intercalaire		----- & : membre de la même famille, document correspondant	

**ANNEXE AU RAPPORT DE RECHERCHE
RELATIF A LA DEMANDE DE BREVET BELGE NO.**

BO 6161
BE 9600637

La présente annexe indique les membres de la famille de brevets relatifs aux documents brevets cités dans le rapport de recherche visé ci-dessus.

Lesdits membres sont contenus au fichier informatique de l'Office européen des brevets à la date du
Les renseignements fournis sont donnés à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité de l'Office européen des brevets.

25-03-1997

Document brevet cité au rapport de recherche	Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
US 3594238 A	20-07-71	AUCUN	
EP 0655515 A	31-05-95	US 4851095 A	25-07-89
		EP 0328257 A	16-08-89
		JP 2004967 A	09-01-90
		US 5124013 A	23-06-92
		US 5225057 A	06-07-93
GB 2197346 A	18-05-88	AUCUN	
US 4740385 A	26-04-88	DE 3641718 A	16-06-88
		US 4815415 A	28-03-89